

3

ดีซีแอมมิเตอร์

DC AMMETER

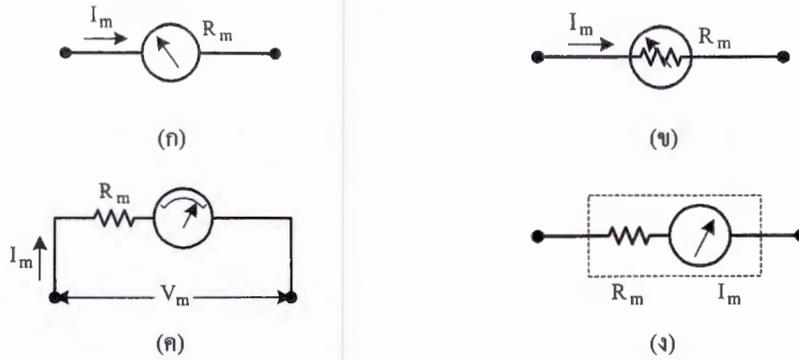
3.1 บทนำ

แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Ammeter) หรือดีซีแอมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) ดีซีแอมมิเตอร์นั้นจัดเป็นเครื่องมือวัดแบบอะนาล็อก (Analog Instrument) หรืออาจจะเรียกว่าเครื่องมือวัดแบบเข็มชี้ (Indicating Instrument) เข็มมิเตอร์จะติดอยู่กับขดลวดเคลื่อนที่แบบคาร์สันวัต โดยจะหมุนไปพร้อมกันเพื่อชี้ค่าบนสเกลของหน้าปัดตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน

ดีซีแอมมิเตอร์จะต้องต่อแบบอนุกรม (Series) ในวงจรนั้นๆ และต้องให้ขั้วของแอมมิเตอร์เหมือนกันกับศักย์ไฟฟ้าของวงจรหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้านั้นคือให้ขั้วบวกของแอมมิเตอร์กับศักย์ไฟฟ้าบวกและขั้วลบของแอมมิเตอร์กับศักย์ไฟฟ้านลบเสมอ แต่ถ้าต่อแอมมิเตอร์ผิดขั้วแล้วจะทำให้เข็มมิเตอร์ตีกลับอาจเกิดการชำรุดเสียหายได้เช่นบิดงอทำให้อ่านค่าที่วัดได้มีค่าความผิดพลาดมากขึ้น

3.2 วงจรเทียบเท่าของขดลวดเคลื่อนที่ (Equivalent Circuit of Moving Coil)

ขดลวดเคลื่อนที่แบบคาร์สันวัตจะพันด้วยลวดตัวนำขนาดเล็กจึงมีความต้านทานขดลวด (Moving Coil Resistance : R_m) เมื่อวัดกระแสไฟฟ้าจะมีขีดจำกัดตามกระแสไฟฟ้าเต็มสเกล (Full Scale Current : I_{fs}) หรือกระแสไฟฟ้าขดลวด (Moving Coil Current : I_m) ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เข็มมิเตอร์เบี่ยงเบนเต็มสเกล (Full Scale Deflection : FSD) และมีแรงดันไฟฟ้าขดลวด (Moving Coil Voltage : V_m) ตกคร่อม ดังนั้นจึงเขียนเป็นวงจรเทียบเท่าของขดลวดเคลื่อนที่ได้ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 วงจรเทียบเท่าแบบต่างๆของขดลวดเคลื่อนที่คาร์สันวัล (PMMC)

จากรูปที่ 3.1 สามารถเขียนวงจรเทียบเท่าของขดลวดเคลื่อนที่ได้หลายลักษณะซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการขยายย่านวัดให้เป็นแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์

จากวงจรเทียบเท่าของขดลวดเคลื่อนที่เขียนสมการได้ดังนี้

$$I_m = \frac{V_m}{R_m} \dots\dots\dots(3.1)$$

- เมื่อ I_m คือกระแสไฟฟ้าขดลวด...แอมแปร์ (A)
- V_m คือแรงดันไฟฟ้าขดลวด...โวลต์ (V)
- R_m คือความต้านทานขดลวด...โอห์ม (Ω)

โดยทั่วไปแล้วกระแสไฟฟ้าขดลวดหรือกระแสไฟฟ้าเต็มสเกลจะมีค่าน้อยมากเป็น μA การใช้ขดลวดเคลื่อนที่วัดกระแสไฟฟ้าให้ได้มากกว่านี้จะต้องทำการขยายย่านวัดให้กับขดลวดเคลื่อนที่เพื่อทำเป็นแอมมิเตอร์หลายย่านวัดได้ตามต้องการ

3.3 การขยายย่านวัดของแอมมิเตอร์ (Extension of Ranges of Ammeter)

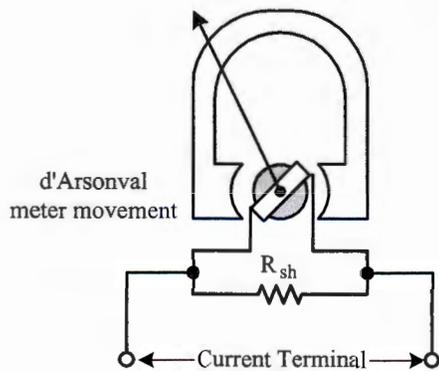
การขยายย่านวัดของขดลวดเคลื่อนที่ให้เป็นแอมมิเตอร์มี 2 วิธีคือ

1. การขยายย่านวัดของแอมมิเตอร์แบบตัวต้านทานชั้นที่ตัวเดียวหรือซิงเกิลชั้น (Single Shunt Type) หรือแบบอินดิวิดวลชั้น (Individual Shunt Type)
2. การขยายย่านวัดของแอมมิเตอร์แบบอาร์ตันชั้น (Ayrton Shunt Type) หรือแบบยูนิเวอร์แซลชั้น (Universal Shunt Type)

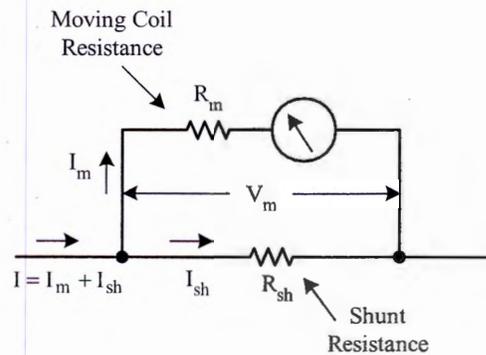
3.3.1 การขยายย่านวัดของแอมมิเตอร์แบบชิงเกิลชันท

(Single Shunt Type of Ammeter)

การขยายย่านวัดของแอมมิเตอร์แบบมีตัวต้านทานชันทตัวเดียวหรือชิงเกิลชันทนั้นจะใช้หลักการของวงจรขนาน (Parallel Circuit) โดยการนำตัวต้านทานชันท (Shunt Resistor : R_{sh}) มาต่อขนานกับขดลวดเคลื่อนที่เพื่อแบ่งกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าแอมมิเตอร์ไม่ให้เกินกระแสไฟฟ้าเต็มสเกลของขดลวดเรียกกระแสไฟฟ้านี้ว่ากระแสไฟฟาชันท (Shunt Current : I_{sh}) และมีกระแสไฟฟ้ารวม (Total Current : I) ไหลเข้าแอมมิเตอร์ซึ่งจะทำให้กระแสไฟฟ้า I เป็นย่านวัด (Range) ของแอมมิเตอร์



(ก) โครงสร้างของคี่ซีแอมมิเตอร์



(ข) วงจรคี่ซีแอมมิเตอร์

รูปที่ 3.2 การขยายย่านวัดของคี่ซีแอมมิเตอร์โดยการต่อตัวต้านทานชันทขนานกับขดลวด

สมการการออกแบบวงจร

จากวงจรขนาน $R_{sh} // R_m$

จะได้ $V_{sh} = V_m$

$$I_{sh} R_{sh} = I_m R_m$$

$$R_{sh} = \frac{I_m R_m}{I_{sh}} \dots \dots \dots (3.2)$$

$$I_{sh} = I - I_m \dots \dots \dots (3.3)$$

แทนสมการ (3.3) : $I_{sh} = I - I_m$ ในสมการ (3.2) จะได้

$$R_{sh} = \frac{I_m R_m}{I - I_m} \quad \dots\dots\dots(3.4)$$

- เมื่อ R_{sh} คือตัวต้านทานชั้นที่... โอห์ม (Ω)
 R_m คือความต้านทานขดลวดเคลื่อนที่... โอห์ม (Ω)
 I_m คือกระแสไฟฟ้าขดลวด... แอมแปร์ (A)
 I คือกระแสไฟฟ้าย่านวัด (Range)... แอมแปร์ (A)
 I_{sh} คือกระแสไฟฟ้าชั้นที่... แอมแปร์ (A)
 V_m คือแรงดันไฟฟ้าขดลวด... โวลต์ (V)
 V_{sh} คือแรงดันไฟฟ้าชั้นที่... โวลต์ (V)

ในการคำนวณหาค่าความต้านทานของตัวต้านทานชั้นที่อีกวิธีหนึ่งโดยการกำหนดให้กระแสไฟฟ้าย่านวัดมีค่าเป็น n เท่าของกระแสไฟฟ้าขดลวด ดังนั้นจะได้ $I = nI_m$ และโดยให้ n เป็นแฟกเตอร์ตัวคูณ (Multiplier Factor)

แทนค่า $I = nI_m$ ในสมการ (3.4)

$$R_{sh} = \frac{I_m R_m}{nI_m - I_m} = \frac{I_m R_m}{I_m (n - 1)}$$

$$R_{sh} = \frac{R_m}{n - 1} \quad \dots\dots\dots(3.5)$$

$$n = \frac{I}{I_m} \quad \dots\dots\dots(3.6)$$

ตัวอย่างที่ 3.1 ขดลวดเคลื่อนที่ตัวหนึ่งมีกระแสไฟฟ้าเต็มสเกล $100\mu\text{A}$ ความต้านทานภายใน 800Ω ต้องการทำเป็นแอมมิเตอร์ขนาด 100mA จงคำนวณหาค่าตัวต้านทานชั้นที่

วิธีทำ

$$R_{sh} = \frac{I_m R_m}{I - I_m}$$

$$R_{sh} = \frac{(100 \times 10^{-6} \text{ A}) \times 800 \Omega}{(100 \times 10^{-3} \text{ A}) - (100 \times 10^{-6} \text{ A})}$$

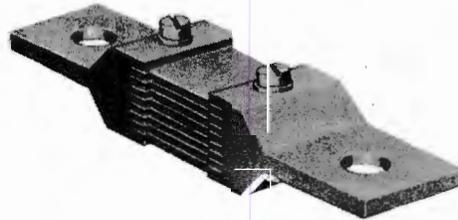
$$R_{sh} = 0.80 \Omega \dots\dots \#$$

กรณีใช้วิธีแฟกเตอร์ตัวคูณ n

$$n = \frac{I}{I_m} = \frac{100 \times 10^{-3} \text{ A}}{100 \times 10^{-6} \text{ A}} = 1000$$

$$R_{sh} = \frac{R_m}{n-1} = \frac{800 \Omega}{1000-1} = 0.80 \Omega \dots\dots\#$$

ตัวต้านทานชั้นที่นั้นจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (Temperature Coefficient) ต่ำมากเช่นทำด้วยทองแดงหรือแมงกานีส (Copper : Cu or Manganin : Mn) ในรูปที่ 3.3 เป็นตัวต้านทานชั้นที่ภายนอก (External Shunt) ต่อกับขดลวดเคลื่อนที่โดยมีความต้านทานต่ำมากใช้กับกระแสไฟฟ้าสูงถึง 8,000 แอมแปร์ซึ่งจะใช้ในแผงสวิตช์บอร์ด (Switchboard)



รูปที่ 3.3 ตัวต้านทานชั้นที่กระแสไฟฟ้าสูงที่ใช้กับเครื่องมือวัดในแผงสวิตช์บอร์ด

ตัวอย่างที่ 3.2 แอมมิเตอร์เครื่องหนึ่งขดลวดเคลื่อนที่ที่มีความต้านทานภายใน 99Ω กระแสไฟฟ้าเต็มสเกล 0.1 mA ต่อขนานกับตัวต้านทานชั้นที่ 1Ω จงคำนวณหากระแสไฟฟ้ารวมที่ไหลเข้าแอมมิเตอร์ ก) FSD ข) 0.5 FSD ค) 0.25 FSD

วิธีทำ

ก) ที่ FSD หากระแสไฟฟ้ารวม I

$$V_m = I_m R_m = 0.1 \text{ mA} \times 99 \Omega = 9.9 \text{ mV}$$

$$I_{sh} R_{sh} = V_m$$

$$I_{sh} = \frac{V_m}{R_{sh}} = \frac{9.9 \text{ mV}}{1 \Omega} = 9.9 \text{ mA}$$

$$I = I_{sh} + I_m = 9.9 \text{ mA} + 0.1 \text{ mA} = 10 \text{ mA} \dots\dots\#$$

ข) ที่ 0.5FSD หากกระแสไฟฟ้ารวม I

$$I_m = 0.5 \times 0.1\text{mA} = 0.05\text{mA}$$

$$V_m = I_m R_m = 0.05\text{mA} \times 99\Omega = 4.95\text{mV}$$

$$I_{sh} = \frac{V_m}{R_{sh}} = \frac{4.95\text{mV}}{1\Omega} = 4.95\text{mA}$$

$$I = I_{sh} + I_m = 4.95\text{mA} + 0.05\text{mA} = 5\text{mA} \dots\#$$

ค) ที่ 0.25FSD หากกระแสไฟฟ้ารวม I

$$I_m = 0.25 \times 0.1\text{mA} = 0.025\text{mA}$$

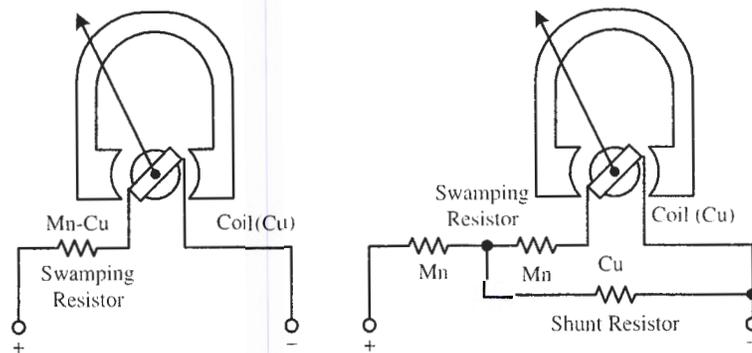
$$V_m = I_m R_m = 0.025\text{mA} \times 99\Omega = 2.475\text{mV}$$

$$I_{sh} = \frac{V_m}{R_{sh}} = \frac{2.475\text{mV}}{1\Omega} = 2.475\text{mA}$$

$$I = I_{sh} + I_m = 2.475\text{mA} + 0.025\text{mA} = 2.5\text{mA} \dots\#$$

ความต้านทานสเวฟปีง (Swamping Resistance)

ขดลวดเคลื่อนที่แบบคาร์สันวัลหรือ PMMC นั้นจะพันด้วยลวดทองแดงมีข้อเสียคือเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุให้ความต้านทานขดลวดเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิด้วย แต่สปริงกันหอยซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไปป้อนให้ขดลวดจะลดความเครียดลง จึงทำให้เข็มมิเตอร์อ่านค่ากระแสไฟฟ้าต่ำกว่าค่าจริง



(ก) การชดเชยอุณหภูมิแบบพื้นฐาน

(ข) การชดเชยอุณหภูมิที่มีการต่อตัวต้านทานชั้นที่

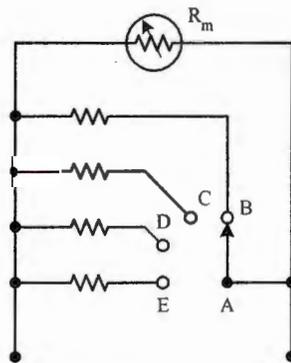
รูปที่ 3.4 การต่อตัวต้านทานสเวฟปีงเพื่อชดเชยอุณหภูมิให้ขดลวด

การแก้ปัญหานี้ด้วยการต่อตัวต้านทานสเวฟปิ้งอนุกรมกับขดลวดเพื่อชดเชยอุณหภูมิดังในรูปที่ 3.4 ซึ่งตัวต้านทานสเวฟปิ้งนั้นจะทำด้วยทองแดง (Cu) หรือแมงกานีส (Mn) ซึ่งมีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำมากจนมีค่าเกือบเท่ากับศูนย์ ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นผลรวมค่าความต้านทานของขดลวดกับตัวต้านทานสเวฟปิ้งจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และเพียงพอต่อการชดเชยการเปลี่ยนแปลงของสปริงกันหอยซึ่งผลของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในขดลวดนั้น จึงได้รับการชดเชยด้วยตัวต้านทานสเวฟปิ้ง

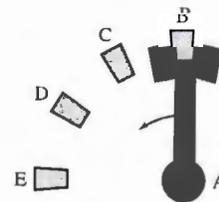
แอมมิเตอร์หลายย่านวัดแบบซิงเกิลชันท

(Single Shunt Type Multi-Range of Ammeter)

แอมมิเตอร์หลายย่านวัดแบบซิงเกิลชันทนั้นในแต่ละย่านวัดต่างจะมีตัวต้านทานชันทแยกอิสระต่อกันและจะเปลี่ยนย่านวัดโดยการใช้สวิทช์เลือก (Selector Switch) แลนี้ข้อเสียเมื่อนำแอมมิเตอร์ไปวัดกระแสไฟฟ้าของวงจรใดๆแล้วในขณะที่เปลี่ยนย่านวัดหนึ่งไปอีกย่านวัดหนึ่งขณะสวิทช์ยังต่อไปไม่ถึงย่านวัดใหม่จะทำให้กระแสไฟฟ้าของวงจรไหลเข้าขดลวดเคลื่อนที่จนเกิดการเสียหายได้จะแก้ปัญหานี้ โดยการใช้สวิทช์เลือกย่านวัดแบบต่อก่อนตัด (Make before Break Switch) ดังรูปที่ 3.5 (ข)



(ก) วงจรแอมมิเตอร์แบบหลายย่านวัด

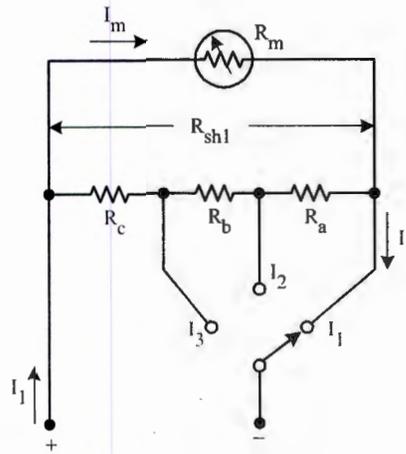


(ข) สวิทช์เลือกแบบต่อก่อนตัด

รูปที่ 3.5 แอมมิเตอร์แบบหลายย่านวัดที่มีตัวต้านทานแบ่งแยกอิสระกันของแต่ละย่านวัด

3.3.2 การขยายย่านวัดของแอมมิเตอร์แบบอาร์ตันชั้นที่
(Ayrton Shunt Type Ammeter)

การขยายย่านวัดของแอมมิเตอร์แบบอาร์ตันชั้นที่ จะใช้หลักการของวงจรขนาน เช่นกัน โดยตัวต้านทานชั้นที่ของย่านวัดต่ำสุดจะถูกแบ่งให้ย่านวัดถัดไปตามลำดับจนถึง ย่านวัดสูงสุด ลักษณะเช่นนี้จะไม่มีปัญหาการเปลี่ยนย่านวัดเหมือนแอมมิเตอร์หลายย่านวัดแบบซิงเกิลชั้นที่ เพราะเหตุว่าจะมีตัวต้านทานชั้นที่ต่อขนานอยู่กับขดลวดเคลื่อนที่เพื่อแบ่งกระแสไฟฟ้าส่วนเกินตลอดเวลา จึงไม่มีกระแสไฟฟ้าของวงจรไหลเข้าขดลวดเคลื่อนที่จนทำให้เกิดการเสียหาย



รูปที่ 3.6 วงจรคีซีแอมมิเตอร์แบบอาร์ตันชั้นที่

สมการการออกแบบวงจร

ย่านวัด I_1 หา R_{sh1}

จากสมการ (3.4) : $R_{sh} = \frac{I_m R_m}{I - I_m}$

จะได้ $R_{sh1} = R_a + R_b + R_c = \frac{I_m R_m}{I_1 - I_m}$ (3.7)

ย่านวัด I_2 หา R_a, R_{sh2}

$R_{sh2} = R_c + R_b$ (3.8)

จากสมการ (3.7) จะได้

$$R_a = R_{sh1} - (R_c + R_b) \quad \dots\dots\dots(3.9)$$

แทนสมการ (3.8) : $R_{sh2} = R_c + R_b$ ในสมการ (3.9)

$$R_a = R_{sh1} - (R_c + R_b) = R_{sh1} - R_{sh2} \quad \dots\dots\dots(3.10)$$

จากวงจรขนาน $R_{sh2} \parallel (R_m + R_a)$

จะได้

$$V_{sh2} = V_{(R_m + R_a)}$$

$$(I_2 - I_m)R_{sh2} = I_m(R_m + R_a) \quad \dots\dots\dots(3.11)$$

แทนสมการ (3.10) : $R_a = R_{sh1} - R_{sh2}$ ในสมการ (3.11)

$$(I_2 - I_m)R_{sh2} = I_m(R_m + R_{sh1} - R_{sh2})$$

$$I_2R_{sh2} - I_mR_{sh2} = I_mR_m + I_mR_{sh1} - I_mR_{sh2}$$

ดังนั้น

$$R_{sh2} = \frac{I_m(R_m + R_{sh1})}{I_2} \quad \dots\dots\dots(3.12)$$

จากสมการ (3.10) , (3.12) หา R_a

ดังนั้น

$$R_a = R_{sh1} - R_{sh2} \quad \dots\dots\dots(3.13)$$

ข่านวัด I_3 หา R_b และ R_c

$$R_{sh3} = R_c \quad \dots\dots\dots(3.14)$$

จากวงจรขนาน $R_{sh3} \parallel (R_m + R_a + R_b)$

จะได้

$$V_{sh3} = V_{(R_m + R_a + R_b)}$$

$$(I_3 - I_m)R_{sh3} = I_m(R_m + R_a + R_b) \quad \dots\dots\dots(3.15)$$

จากสมการ (3.7) จะได้

$$R_a + R_b = R_{sh1} - R_c \quad \dots\dots\dots(3.16)$$

แทนสมการ (3.14) : $R_c = R_{sh3}$ ในสมการ (3.16)

$$R_a + R_b = R_{sh1} - R_{sh3} \quad \dots\dots\dots(3.17)$$

แทนสมการ (3.17) : $R_a + R_b = R_{sh1} - R_{sh3}$ ในสมการ (3.15)

$$(I_3 - I_m)R_{sh3} = I_m(R_m + R_{sh1} - R_{sh3})$$

$$I_3R_{sh3} - I_mR_{sh3} = I_mR_m + I_mR_{sh1} - R_{sh3}$$

$$R_{sh3} = R_c = \frac{I_m(R_m + R_{sh1})}{I_3} \quad \dots\dots\dots(3.18)$$

จากสมการ (3.8) และ (3.18) หา R_b

$$\begin{aligned} R_b &= R_{sh2} - R_c \\ R_b &= R_{sh2} - R_{sh3} \end{aligned} \dots\dots\dots(3.19)$$

สรุปการออกแบบคีชีแอมมิเตอร์แบบอาร์ตันชั้นที่

ย่านวัด I_1

$$R_{sh1} = R_a + R_b + R_c = \frac{I_m R_m}{I_1 - I_m}$$

ย่านวัด I_2

$$R_{sh2} = R_b + R_c = \frac{I_m (R_m + R_{sh1})}{I_2}$$

$$R_a = R_{sh1} - R_{sh2}$$

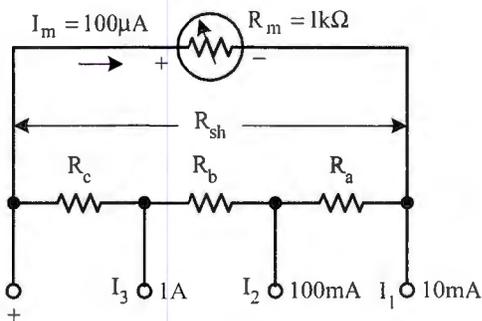
ย่านวัด I_3

$$R_{sh3} = R_c = \frac{I_m (R_m + R_{sh1})}{I_3}$$

$$R_b = R_{sh2} - R_{sh3}$$

จะสังเกตได้ว่าสมการหา R_{sh2} และ R_{sh3} จะมีเศษเหมือนกันแต่ส่วนจะต่างกันเท่านั้นซึ่งส่วนจะเป็นค่าของย่านวัดคือ I_2 และ I_3 ตามลำดับ ดังนั้นในทำนองเดียวกันแล้วถ้าแอมมิเตอร์มีย่านวัดเพิ่มเป็น I_4 และ I_5 สมการหา R_{sh4} และ R_{sh5} จะมีเศษเหมือนกันกับ R_{sh2} และ R_{sh3} ด้วยโดยส่วนจะเป็น I_4 และ I_5 ตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 3.3 จงคำนวณหาตัวต้านทานแบบอาร์ตันชั้นที่ของแอมมิเตอร์ในวงจรที่กำหนดให้



วิธีทำ

ย่านวัด $I_1 = 10\text{mA}$

$$\text{หา } R_{sh1} = R_a + R_b + R_c$$

$$n = \frac{I}{I_m} = \frac{10\text{mA}}{100\mu\text{A}} = 100$$

$$R_{sh1} = R_a + R_b + R_c = \frac{R_m}{n-1} = \frac{1\text{k}\Omega}{100-1} = 10.1\Omega$$

ย่านวัด $I_2 = 100\text{mA}$

$$\text{หา } R_a \text{ และ } R_{sh2}$$

$$R_{sh2} = R_b + R_c = \frac{I_m(R_m + R_{sh1})}{I_1}$$

$$R_{sh2} = \frac{100\mu\text{A}(1\text{k}\Omega + 10.1\Omega)}{100\text{mA}} = 1.01\Omega$$

$$R_a = R_{sh1} - R_{sh2} = 10.1\Omega - 1.01\Omega = 9.09\Omega \dots\#$$

ย่านวัด $I_3 = 1\text{A}$

$$\text{หา } R_c : R_{sh3} \text{ และ } R_b$$

$$R_{sh3} = R_c = \frac{I_m(R_m + R_{sh1})}{I_3}$$

$$R_{sh3} = \frac{100\mu\text{A}(1\text{k}\Omega + 10.1\Omega)}{1\text{A}} = 0.101\Omega$$

$$R_b = R_{sh2} - R_{sh3} = 1.01\Omega - 0.101\Omega = 0.909\Omega \dots\#$$

$$R_c = R_{sh3} = 0.101\Omega \dots\#$$

ตัวอย่างที่ 3.4 ถ้าแอมมิเตอร์หลายย่านวัดแบบอาร์ตันจันท์เหมือนวงจรในตัวอย่างที่ 3.3 มี

$$R_c = 0.05\Omega, R_b = 0.45\Omega, R_a = 4.5\Omega \text{ และขดลวดเคลื่อนที่ PMMC มี } R_m = 1\text{k}\Omega,$$

$$I_{fs} = 50\mu\text{A} \text{ จงคำนวณหาย่านวัดทั้ง 3 ย่านวัดของแอมมิเตอร์}$$

วิธีทำ

หาย่านวัด I_1

$$V_m = I_m R_m = 50\mu\text{A} \times 1\text{k}\Omega = 50\text{mV}$$

$$I_{sh1} = \frac{V_m}{R_c + R_b + R_a} = \frac{50\text{mV}}{0.05\Omega + 0.45\Omega + 4.5\Omega} = 10\text{mA}$$

$$I_1 = I_m + I_{sh1} = 50\mu\text{A} + 10\text{mA} = 10.05\text{mA} \approx 10\text{mA} \dots\#$$

ห่าย่านวัด I_2

$$V_{sh2} = I_m (R_m + R_a) = 50\mu A (1k\Omega + 4.5\Omega) \approx 50mV$$

$$I_{sh2} = \frac{V_{sh2}}{R_c + R_b} = \frac{50mV}{0.05\Omega + 0.45\Omega} = 100mA$$

$$I_2 = I_m + I_{sh2} = 50\mu A + 100mA = 100.05mA \approx 100mA \dots\#$$

ห่าย่านวัด I_3

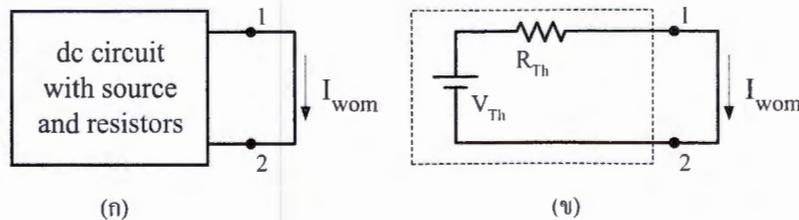
$$V_{sh3} = I_m (R_m + R_a + R_b) = 50\mu A (1k\Omega + 4.5\Omega + 0.45\Omega) = 50mV$$

$$I_{sh3} = \frac{V_{sh3}}{R_c} = \frac{50mV}{0.05\Omega} = 1A$$

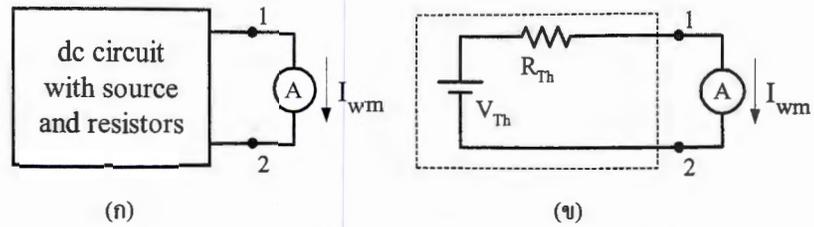
$$I_3 = I_m + I_{sh3} = 50\mu A + 1A = 1.00005A \approx 1A \dots\#$$

3.4 ผลการโหลดของแอมมิเตอร์ (Ammeter Loading Effects)

แอมมิเตอร์ทางอุดมคติ (Ideal Ammeter) จะพิจารณาให้ค่าความต้านทานภายใน (R_m) ของย่านวัดเท่ากับศูนย์โอห์ม เมื่อนำแอมมิเตอร์นี้ไปวัดกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าใดๆจะวัดค่าได้ถูกต้องแม่นยำไม่เกิดค่าความผิดพลาดจากการวัด แต่ในความเป็นจริงแล้วแอมมิเตอร์จะมีความต้านทานภายในซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อต่อในวงจรไฟฟ้าจะทำให้เพิ่มค่าความต้านทานเป็นผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้ต่ำกว่าค่ากระแสไฟฟ้าจริง โดยค่าความผิดพลาดจากการวัดนี้เกิดจากผลการโหลดของแอมมิเตอร์ การลดผลการโหลดของแอมมิเตอร์ โดยการเปลี่ยนย่านวัดให้สูงขึ้นเพื่อลดค่าความต้านทานภายในของย่านวัด ทั้งนี้เพราะว่าย่านวัดสูงกว่าจะมีค่าความต้านทานภายในต่ำกว่าความต้านทานภายในของย่านวัดต่ำและอีกวิธีหนึ่งคือการใช้วงจรเทียบเท่าเทวินิน (Thevenin Equivalent Circuit) พิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานเทียบเท่าเทวินินของวงจรไฟฟ้านั้นกับความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์



รูปที่ 3.7 วงจรเทียบเท่าเทวินินของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อไม่ต่อแอมมิเตอร์



รูปที่ 3.8 วงจรเทียบเท่าเทวินินของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อต่อแอมมิเตอร์

การคำนวณค่าความถูกต้องและค่าความผิดพลาด

หลักการคือหาวงจรถียบเท่าเทวินิน ของวงจรไฟฟ้าที่ต้องการวัดหากระแสไฟฟ้า
ดังนี้

จากรูปที่ 3.7 (ข) หา I_{wom}

$$I_{wom} = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} \dots\dots\dots(3.20)$$

จากรูปที่ 3.8 (ข) หา I_{wm} โดยให้ R_{ir1} เป็นความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์

$$I_{wm} = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_{in}} \dots\dots\dots(3.21)$$

สมการ (3.20) จะได้เป็นค่าความถูกต้องจากการวัด (Accuracy : A) คือ

$$Accuracy = \frac{I_{wm}}{I_{wom}} = \frac{R_{Th}}{R_{Th} + R_{in}} \dots\dots\dots(3.22)$$

เปอร์เซ็นต์ค่าความถูกต้องจากการวัดคือ

$$\%Acc = \frac{I_{wm}}{I_{wom}} \times 100\%$$

$$\%Acc = \frac{R_{Th}}{R_{Th} + R_{in}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.23)$$

เปอร์เซ็นต์ค่าความผิดพลาดจากการวัดคือ

$$\%Error = 1 - \%Acc = \left| \frac{X_t - X_m}{X_t} \right| \times 100\%$$

$$\%Error = \left| \frac{I_{wom} - I_{wm}}{I_{wom}} \right| \times 100\% \dots\dots\dots(3.24)$$

- เมื่อ I_{wm} คือกระแสไฟฟ้ามิเตอร์ (Current with Meter)
หรือค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้ (X_m) ...แอมแปร์ (A)
- I_{wom} คือกระแสไฟฟ้าไม่มีมิเตอร์ (Current without Meter)
หรือค่ากระแสไฟฟ้าจริง (X_t) ...แอมแปร์ (A)
- R_{Th} คือความต้านทานเทียบเท่าเทวินิน... โอห์ม (Ω)
- R_{in} คือความต้านทานภายในของมิเตอร์... โอห์ม (Ω)
- %Accuracy คือเปอร์เซ็นต์ค่าความถูกต้องจากการวัด
- %Error คือเปอร์เซ็นต์ค่าความผิดพลาดจากการวัด

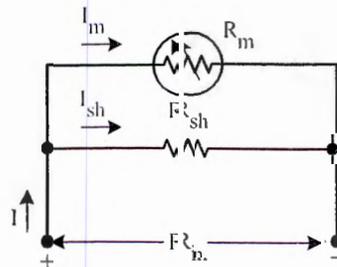
3.5 ความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์ (Internal Ammeter Resistance : R_m)

ความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์ ถ้ากรณีเป็นขดลวดเคลื่อนที่จะพิจารณาจากความต้านทานขดลวด แต่ถ้าเป็นแอมมิเตอร์ที่มีการขยายย่านวัดแล้วความต้านทานภายในจะพิจารณาจากความต้านทานของย่านวัดนั้นๆ โดยเป็นไปตามชนิดตัวต้านทานชั้นที่ไม่ว่าจะเป็นแบบเชิงเกิลชันทหรืออาร์ตันชั้น

พิจารณาความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์แบบเชิงเกิลชันทจากรูปที่ 3.9 ซึ่งมีย่านวัด I จะเห็นว่ากระแสไฟฟ้า I ของย่านวัดจะเป็นกระแสไฟฟารวม (I_t) ที่ไหลเข้าแอมมิเตอร์

$$R_{in} = R_m // R_{sh} = \frac{R_m R_{sh}}{R_m + R_{sh}} \dots\dots\dots(3.25)$$

ในทำนองเดียวกันความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์แบบอาร์ตันชั้นจะเท่ากับผลรวมความต้านทานชั้นของแต่ละย่านวัด ถ้าย่านวัดสูงสุดจะมีความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์จะต่ำสุด



รูปที่ 3.9 ความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์แบบเชิงเกิลชันท

การคำนวณค่าความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์

จากรูปที่ 3.9 หาค่าความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์

$$\text{จะได้ } R_{in} = \frac{V_m}{I_{range}} = \frac{V_m}{I} = \frac{I_m R_m}{I} \quad \dots\dots\dots(3.26)$$

$$\text{จากสมการ (3.6) : } n = \frac{I}{I_m}$$

$$\text{จะได้ } I = n I_m \quad \dots\dots\dots(3.27)$$

จากสมการ (3.27) กระแสไฟฟ้าของย่านวัด I มีค่ามากกว่ากระแสไฟฟ้าขดลวด I_m เท่ากับ n เท่า

$$\text{แทนสมการ (3.27) : } I = n I_m \text{ ในสมการ (3.26)}$$

$$\text{จะได้ } R_{in} = \frac{I_m R_m}{I} = \frac{I_m R_m}{n I_m}$$

$$R_m = \frac{R_m}{n} \quad \dots\dots\dots(3.28)$$

จากสมการ (3.28) จะได้ความต้านทานภายใน R_{in} มีค่าลดลงเท่ากับ n เท่าของความต้านทานขดลวด R_m หรือกล่าวได้ว่าความต้านทานขดลวด R_m เท่ากับ n เท่าของความต้านทานภายใน R_{in} ดังนี้

$$R_m = n R_{in} \quad \dots\dots\dots(3.29)$$

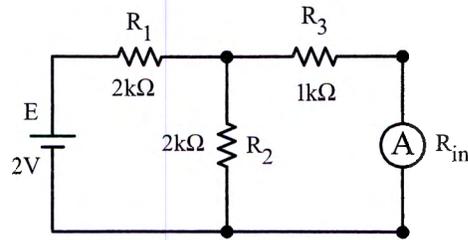
ตัวอย่างที่ 3.6 ถ้าขดลวดเคลื่อนที่มีความต้านทาน 50Ω และกระแสไฟฟ้าขดลวด 1mA ต้องการขยายย่านวัดเป็น 10mA จะทำให้แอมมิเตอร์มีความต้านทานภายในเท่าไร

วิธีทำ

$$R_{in} = \frac{I_m R_m}{I} = \frac{1\text{mA}}{10\text{mA}} R_m = \frac{1}{10} R_m$$

$$R_{in} = \frac{50\Omega}{10} = 5\Omega \dots\dots\#$$

ตัวอย่างที่ 3.7 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงกำหนดให้ $R_1 = 2k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 1k\Omega$ แรงดันไฟฟ้า $E = 2V$ ให้วัดกระแสไฟฟ้า I_{R_3} ด้วยแอมมิเตอร์ที่มีความต้านทานภายใน $R_{in} = 100\Omega$ และจงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องและความผิดพลาดจากการวัด



วิธีทำ

หา R_{Th}, V_{Th}

$$R_{Th} = R_1 // R_2 + R_3 = 2k\Omega // 2k\Omega + 1k\Omega = 2k\Omega$$

$$V_{Th} = \left(\frac{E}{R_1 + R_2} \right) R_2 = \left(\frac{2V}{2k\Omega + 2k\Omega} \right) \times 2k\Omega = 1V$$

หา I_{wom}, I_{wm}

$$I_{wom} = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} = \frac{1V}{2k\Omega} = 500\mu A$$

$$I_{wm} = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_{in}} = \frac{1V}{2k\Omega + 100\Omega} = 476.19\mu A \dots\dots\#$$

หา %Acc

$$\%Acc = \frac{I_{wm}}{I_{wom}} \times 100\%$$

$$\%Acc = \frac{476.19\mu A}{500\mu A} \times 100\% = 95.24\% \dots\dots\#$$

หรือ

$$\%Acc = \frac{R_{Th}}{R_{Th} + R_{in}} \times 100\%$$

$$\%Acc = \frac{2k\Omega}{2k\Omega + 100\Omega} \times 100\% = 95.24\% \dots\dots\#$$

หา %Error

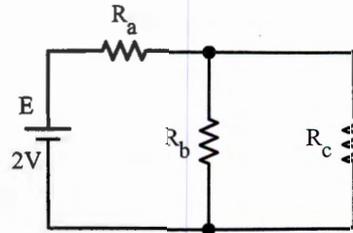
$$\%Error = 1 - \%Acc = 1 - 95.24\% = 4.76\% \dots\dots\#$$

หรือ

$$\%Error = \left| \frac{I_{wom} - I_{wm}}{I_{wom}} \right| \times 100\%$$

$$\%Error = \left| \frac{250\mu A - 238.095\mu A}{250\mu A} \right| \times 100\% = 4.76\% \dots\dots\#$$

ตัวอย่างที่ 3.8 แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มีความต้านทานภายใน 78Ω ใช้วัดกระแสไฟฟ้าของ R_c จงคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจากผลการไหลของแอมมิเตอร์



วิธีทำ

ห1 R_{Th} , V_{Th}

$$R_{Th} = R_a // R_b + R_c = 1k\Omega // 1k\Omega + 1k\Omega = 1.5k\Omega$$

$$V_{Th} = \left(\frac{E}{R_a + R_b}\right)R_b = \left(\frac{3V}{1k\Omega + 1k\Omega}\right) \times 1k\Omega = 1.5V$$

ห1 Accuracy , Error

$$Accuracy = \frac{R_{Th}}{R_{Th} + R_{in}} = \frac{1.5k\Omega}{1.5k\Omega + 78\Omega} = 0.95 = 95\% \dots\dots\#$$

$$Error = 1 - Accuracy = 1 - 0.95 = 0.05 = 5\% \dots\dots\#$$

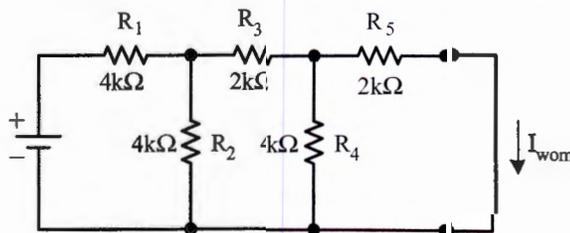
ห1 I_{wom} , I_{wm}

$$I_{wom} = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} = \frac{1.5V}{1.5k\Omega} = 1mA \dots\dots\#$$

$$I_{wm} = \left(\frac{R_{Th}}{R_{Th} + R_{in}}\right)I_{wom}$$

$$I_{wm} = \left(\frac{1.5k\Omega}{1.5k\Omega + 78\Omega}\right) \times 1mA = 0.95mA \dots\dots\#$$

ตัวอย่างที่ 3.9 แอมมิเตอร์มีความต้านทานภายใน $1k\Omega$ ใช้วัดกระแสไฟฟ้าในวงจรที่กำหนดให้ ถ้าว่านค่ากระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์ได้ $40\mu A$ จงคำนวณหา I_{wom} , %Acc และ %Error



วิธีทำ

หาค่า R_{Th} , I_{wom}

$$R_{Th} = (R_1 // R_2 + R_3) // R_4 + R_5$$

$$R_{Th} = (1k\Omega // 4k\Omega + 2k\Omega) // 4k\Omega + 2k\Omega = 4k\Omega$$

$$I_{wom} = \frac{I_{wm} (R_{Th} + R_{in})}{R_{Th}}$$

$$I_{wom} = \frac{40\mu A (4k\Omega + 1k\Omega)}{4k\Omega} = 50\mu A \dots\dots\#$$

หาค่า %Acc

$$Accuracy = \frac{R_{Th}}{R_{Th} + R_{in}}$$

$$Accuracy = \frac{4k\Omega}{4k\Omega + 1k\Omega} = 0.80 = 80\% \dots\dots\#$$

หาค่า %Error

$$Error = 1 - Accuracy = 1 - 0.80 = 0.20 = 20\% \dots\dots\#$$

จากตัวอย่างที่ 3.9 ได้ค่าความถูกต้อง 80% หมายถึงแอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าได้ 80% ของกระแสไฟฟ้าจริงในวงจรและที่ได้ค่าความผิดพลาด 20% จะหมายถึงแอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าได้ต่ำกว่ากระแสไฟฟ้าจริงในวงจร 20%

3.6 การเลือกแอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าให้ได้ค่าความถูกต้องสูงสุด

การวัดกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าใดๆนั้น จะมีปัญหาจากผลการไหลของแอมมิเตอร์ซึ่งมีมากหรือน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้านทานภายใน R_{in} และความต้านทานเทียบเท่าเทวินิน R_{Th} ของวงจรที่ต้องการวัดกระแสไฟฟ้านั้น ดังนั้น ค่าความถูกต้องจากการวัดจะขึ้นอยู่กับว่า R_{Th} มีค่ามากกว่า R_{in} เป็นกี่เท่า

ตัวอย่างที่ 3.10 ถ้ากำหนดให้ R_{Th} เท่ากับ $100R_{in}$ จะมีค่าความถูกต้องจากการวัดเท่าไร

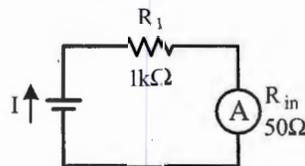
วิธีทำ

$$Accuracy = \frac{R_{Th}}{R_{Th} + R_{in}}$$

$$Accuracy = \frac{100R_{in}}{100R_{in} + R_{in}} = 0.99 = 99\% \dots\dots\#$$

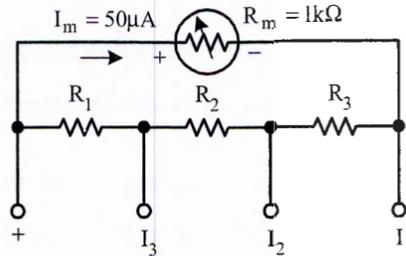
แบบฝึกหัดที่ 3

- จงคำนวณหาค่าตัวต้านทานชั้นที่เปลี่ยนขดลวดเคลื่อนที่มีความต้านทานภายใน 105Ω และกระแสเต็มสเกล 1mA ให้เป็นแอมมิเตอร์ที่มีย่านวัดเป็น 150mA
- แอมมิเตอร์แบบซิงเกิลชั๊นท์ที่มีกระแสเต็มสเกล 1mA ความต้านทานภายใน 50Ω จงคำนวณหา
 - ตัวต้านทานขนานที่ย่านวัด 3mA และความต้านทานภายใน
 - ตัวต้านทานขนานที่ย่านวัด 1A และความต้านทานภายใน
- แอมมิเตอร์หลายย่านวัดแบบซิงเกิลชั๊นท์ กำหนดให้ขดลวดเคลื่อนที่มีความต้านทานภายใน $2\text{k}\Omega$ กระแสไฟฟ้าเต็มสเกล $50\mu\text{A}$ ต้องการขยายย่านวัดเป็น $5, 50$ และ 500mA จงคำนวณหา
 - ตัวต้านทานขนานของแต่ละย่านวัด
 - ความต้านทานภายใน
- แอมมิเตอร์มีย่านวัดเป็น 1mA ถูกกำหนดจากโรงงานมีค่าผิดพลาดการปรับแต่ง (Calibration Error) $\pm 5\%$ ของ FSD ถ้าอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากการวัดโหลดของวงจรได้ 0.35mA จงคำนวณหาค่าอ่านของกระแสไฟฟ้าจริงที่ไหลผ่านมิเตอร์
- ถ้าแอมมิเตอร์มีความต้านทานขดลวด 50Ω และกระแสไฟฟ้าเต็มสเกล 1mA ถ้าให้แอมมิเตอร์มี Calibration Error $\pm 5\%$ of FSD จงคำนวณหาช่วงของกระแสไฟฟ้าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์

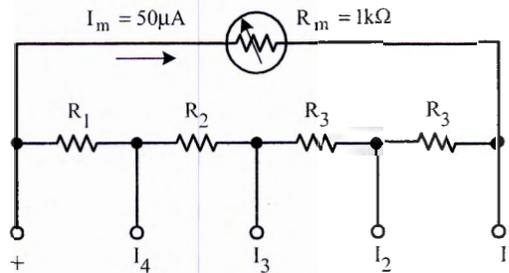


- แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสร้างจากการต่อตัวต้านทาน 133.3Ω ขนานกับขดลวดเคลื่อนที่ $1.2\text{k}\Omega, 30\mu\text{A}$ FSD จงคำนวณหากระแสไฟฟ้าที่
 - FSD
 - 0.5FSD
 - 0.33FSD

7. จงคำนวณหาค่าตัวต้านทาน R_1 ถึง R_3 ในวงจรแอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อให้ขดลวดมี $R_m = 1k\Omega, I_m = 50\mu A$ และ $I_1 = 1mA, I_2 = 10mA, I_3 = 100mA$



8. จงแสดงคำนวณหาค่าตัวต้านทาน R_1 ถึง R_4 ของแอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงถ้าขดลวด PMMC มี $R_m = 1k\Omega, I_m = 50\mu A$ และ $I_1 = 100\mu A, I_2 = 1mA, I_3 = 10mA, I_4 = 100mA$

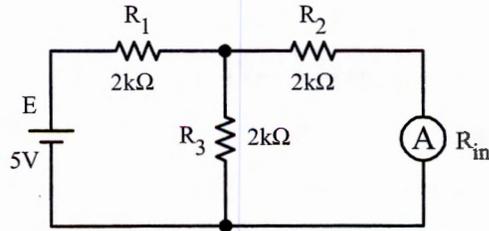


9. วงจรไฟฟ้ากระแสตรงมี $E = 1V, R = 1k\Omega$ ให้วัดกระแสไฟฟ้าของวงจรด้วยแอมมิเตอร์มีค่าความต้านทานภายใน 200Ω จะอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้เท่าไร
10. ถ้าขดลวดเคลื่อนที่มีกระแสไฟฟ้าเต็มสเกล $1mA$ ความต้านทานภายใน 50Ω ต่อกับตัวต้านทานชั้นที่ 1Ω จงคำนวณหา
- ความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์
 - ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่แอมมิเตอร์จะวัดได้
 - แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมแอมมิเตอร์เมื่อกระแสไฟฟ้าเต็มสเกล
11. ในการวัดกระแสไฟฟ้าให้ได้ค่าความถูกต้องจากการวัดเท่ากับ 95% จะต้องให้ค่า R_{Th} ของวงจรที่ต้องการวัดเป็นกี่เท่าของค่า R_m ของแอมมิเตอร์

12. จากวงจรที่กำหนดให้ถ้าต้องการให้ได้ %Error จากการวัดด้วยแอมมิเตอร์เท่ากับ 5%

ก) จะต้องใช้แอมมิเตอร์มีความต้านทานภายในเท่าไร

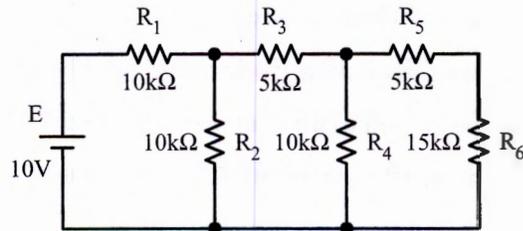
ข) ถ้าแอมมิเตอร์มีความต้านทานภายใน 100Ω จะเกิดเปอร์เซ็นต์ค่าความผิดพลาดเท่าไร



13. จงคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R_6 เมื่อวัดด้วยแอมมิเตอร์ที่มีความต้านทานภายใน $2k\Omega$

ก) จะอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้เท่าไร

ข) ถ้าต้องการวัดกระแสไฟฟ้าในข้อ ก) ให้มีค่าความถูกต้องจากการวัดได้ 99% จะต้องใช้แอมมิเตอร์มีความต้านทานภายในเท่าไร



14. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 12V, 25A ป้อนให้โหลดตัวหนึ่ง จงคำนวณกระแสไฟฟ้าของโหลดเมื่อวัดด้วยแอมมิเตอร์ที่มีความต้านทานภายใน ก) 0.12Ω ข) 0.52Ω ค) 0.002Ω

15. แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมี PMMC $1.2k\Omega$, $100\mu A$ FSD ต่อขนานกับตัวต้านทานอาร์ตัน 0.1Ω โดยมีตัวต้านทาน 4 ตัวต่ออนุกรมกัน จงคำนวณหาค่าย่านวัดของแอมมิเตอร์